イオン液体/ルブレン単結晶界面の微視的構造評価とデバイス特性

(阪大院基礎工¹,東大院新領域²)

<u>横田 泰之¹</u>, 原 援又¹, 森野 裕介¹, 坂東 賢一¹, 今西 哲士¹, 岡田 悠悟², 松井 弘之², 植村 隆文², 竹谷 純一², 福井 賢一¹

Structural and transport properties of ionic liquid / ruburene single crystal interfaces

(Grad. Sch. Engineer. Sci. Osaka Univ.¹, Grad. Sch. Front. Sci., Univ. Tokyo²) <u>Y. Yokota¹</u>, H. Hara¹, Y. Morino¹, K. Bando¹, A. Imanishi¹, Y. Okada², H. Matsui², T. Uemura², J. Takeya², K. Fukui¹

【序】

近年、動作電圧の大幅な低下やキャリア密度の増加が容易に実現できることから、イオン液体-固体界面を利用した電気二重層 FET が注目を集めている[1]。イオン液体は電位窓が広いといった ユニークな特徴を有しているため近年急速に電気化学デバイスへの応用が展開されている。中で も、ルブレン単結晶とイオン液体の界面を利用した電気二重層 FET では移動度が 10 cm²/V s に迫 る値が報告されており[2]、界面の微視的理解による更なる性能向上が期待されている。我々は、 周波数変調原子間力顕微鏡(FM-AFM)を用いた実験により、イオン液体中でグラファイトやマイカ など原子レベルで平坦な表面上にイオン液体分子からなる固体的な構造が不均一な厚みで形成す ることを明らかにしており[3]、このような構造がルブレン界面においても形成すると FET の高速 動作に大きな影響を与えると考えられる。そこで本研究では FM-AFM を用いてイオン液体/ルブ レン単結晶界面の局所構造の観察を行うことで、表面形状とデバイス特性の関係について検討を 行った。

【実験】

実験には、Agilent Technology 社製の 5500 SPM と Nanonis 社製 OC4 を組み合わせた電気化学 FM-AFM [4]を用いた。 試料は、ガラス基板に貼り付けたルブレン単結晶に BMIM-TFSI イオン液体を滴下したものを使用し、カンチ レバーは背面 Au コートの Si 製カンチレバー (PPP-NCHAuD、NanoSensors、バネ定数 40 N/m)を用いて 測定した。電気化学 FM-AFM の場合には、動作電極とし て金基板上にルブレンを貼り合わせたものを用い、参照電 極と対電極にはそれぞれアニール処理後の金線と白金線 を用いた(図 1)。



図 1. 電気化学環境下での FM-AFM 測定

【結果と考察】

大気中観察でほとんどステップが観測されない平坦なルブレン単結晶を注意深く作製し、 BMIM-TFSI 中で FM-AFM 観察を行った[5]。イオン液体を滴下して 30 分後の表面には、大気中で は見られなかった小さな分子欠陥が多数観察された(図 2(a))。26 時間後には欠陥のサイズが大き くなり、ルブレン1層分に対応する 1.4 nm のステップ構造として観察された(図 2(b)(d))。さらに 時間が経過すると欠陥同士が融合することで平坦な構造に回復していった(図 2(c))。このようなル ブレン分子の自発的な溶出は、AFM 探針の掃引効果による溶出とは時間スケールが全く異なるこ

4B05

とが分かっている[6]。図(b)(c)か ら明らかなように表面二層目の 溶出はほとんど進行しないこと から、自発的溶出は元々存在する 表面欠陥サイトから進行してい ると考えられる。

高分解能観察を行うと分子ス ケールの周期構造が観察され(図 2(e))、この周期構造はルブレン結 晶の分子配列と良い一致を示し た(図 2(f))。この像は、湊らによ る超高真空中の NC-AFM による ルブレン単結晶表面の観察結果 とも良く対応する[7]。以上の結 果から、イオン液体中のFM-AFM で観察されているのはルブレン 表面であり、グラファイトやマイ カ上で確認されたようなイオン 液体の固体的な層は、ルブレンと



図 2. (a)–(c) BMIM-TFSI/ルブレン界面の FM-AFM 像(3×3 μ m²)。 (a) $A_{p-p} = 0.80$ nm、 $\Delta f = +120$ Hz、(b) $A_{p-p} = 1.41$ nm、 $\Delta f = +100$ Hz、(c) $A_{p-p} = 0.74$ nm、 $\Delta f = +200$ Hz。(d) 像(b)のラインプロファイル。 (e)(f) 高分解 FM-AFM 像とルブレン単結晶の分子配列。 $A_{p-p} = 1.37$ nm、 $\Delta f = +500$ Hz。(f)の四角はユニットセル(7.2 Å×14.2 Å)を表す。

の界面には形成されないことが明らかとなった。分子動力学計算の結果から、ルブレン表面とイ オン液体の相互作用は比較的弱いことが分かり、これはグラファイトやマイカの場合に顕著な疎 溶媒性相互作用や静電相互作用が弱いためであると考えている。

以上の結果から、ルブレン単結晶をイオン液体中に浸漬す ることで、欠陥の少ない分子レベルで平坦な面が形成される ことが分かった。電気二重層 FET では界面近傍のみに大きな 電場がかかるため、分子欠陥やステップの増減が FET 特性に 大きな影響を及ぼすことが予想される[8]。そこで、図 3 に示 した電気二重層 FET を作製し、デバイス特性の経時変化の検 討を行ったところ、FM-AFM 測定におけるルブレン分子の自 発的溶出とほぼ同程度の時間スケールでデバイス特性が向上 する結果が得られた。これは、キャリア移動を妨げる原因と なる表面欠陥やステップが、時間とともに減少したためであ ると考えられる。発表では、デバイス特性の詳細について議 論する予定である。



図 3. 電気二重層 FET の写真。 S: ソース電極、D: ドレイン電極。

References

[1] T. Fujimoto, K. Awaga, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 8983 (2013).

[2] S. Ono, S. Seki, R. Hirahara, Y. Tominari, J. Takeya, Appl. Phys. Lett. 92, 103313 (2008).

[3] Y. Yokota, T. Harada, K. Fukui, Chem. Commun. 46, 8627 (2010).

[4] K. Umeda, K. Fukui, Langmuir, 26, 9104 (2010).

[5] Y. Yokota, H. Hara, T. Harada, A. Imanishi, T. Uemura, J. Takeya, K. Fukui, *Chem. Commun.* 49, 10596, (2013).

[6] Y. Yokota, H. Hara, Y. Morino, K. Bando, A. Imanishi, T. Uemura, J. Takeya, K. Fukui, *Appl. Phys. Lett.* **104**, 263102 (2014).

[7] T. Minato, H. Aoki, H. Fukidome, T. Wagner, K. Itaya, Appl. Phys. Lett. 95, 093302 (2009).

[8] E. Menard, V. Podzorov, S.-H. Hur, A. Gaur, M. E. Gershenson, J. A. Rogers, *Adv. Mater.* 16, 2097 (2004).